

Declaration and Power of Attorney for Patent Application

(特許出願宣言書及び委任状)

Japanese Language Declaration

日本語宣言書

私は、以下に記名された発明者として、ここに下記の通り宣言する：

As a below named inventor, I hereby declare that:

山田 透**YAMADA ,Toru**

私の住所、郵便の宛先そして国籍は、私の氏名の後に記載された通りである。

379-0196 日本国群馬県安中市磯部二丁目13番1号
信越半導体株式会社 半導体磯部研究所内

My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.

c/o SHIN-ETSU HANDOTAI CO., LTD.,
Isobe R&D Center, 13-1, Isobe
2-chome, Annaka-shi, Gunma 379-0196
JAPAN

下記の名称の発明について、特許請求範囲に記載され、且つ特許が求められている発明主題に関して、私は、最初、最先且つ唯一の発明者である。(唯一の氏名が記載されている場合)か、或いは最初、最先且つ共同発明者である(複数の氏名が記載されている場合)と信じている。

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

気相成長装置およびエピタキシャルウェーハの製造方法**VAPOR PHASE GROWTH APPARATUS AND METHOD OF FABRICATING EPITAXIAL WAFER**

上記発明の明細書はここに添付されているが、下記の欄がチェックされている場合は、この限りではない：

the specification of which is attached hereto unless the following box is checked:

☐ 2004年11月18日の日に出願され、
この出願の米国出願番号または PCT 国際出願番号は、
PCT/JP2004/017192 であり、且つ
の日に補正された出願 (該当する場合)☐ was filed on 18/11/2004
as United States Application Number or
PCT international Application Number
PCT/JP2004/017192 and was amended on
(if applicable).

私は、上記の補正書によって補正された、特許請求範囲を含む上記明細書を検討し、且つ内容を理解していることをここに表明する。

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

私は、連邦規則法典第37編規則1.56に定義されている、特許性について重要な情報を開示する義務があることを認める。

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37. Code of Federal Regulations, Section 1.56.

Japanese Language Declaration

(日本語宣言書)

私は、ここに、以下に記載した外国での特許出願または発明者証の出願、或いは米国以外の少なくとも一國を指定している米国家典第35編第365条(a)によるPCT国際出願について、同第119条(a)・(d)項又は第365条(b)項に基づいて優先権を主張するとともに、優先権を主張する本出願の出願日よりも前の出願日を有する外国での特許出願または発明者証の出願、或いはPCT国際出願については、いかなる出願も、下記の枠内をチェックすることにより示した。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, Section 119(a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application for which priority is claimed.

Prior Foreign Application(s)
外国での先行出願

Priority Not Claimed
優先権主張なし

2003-419202

JAPAN

17/12/2003

(Number)
(番号)

(Country)
(国名)

(Day/Month/Year Filed)
(出願日/月/年)



(Number)
(番号)

(Country)
(国名)

(Day/Month/Year Filed)
(出願日/月/年)



私は、ここに、下記のいかなる米国仮特許出願についても、その米国家典第35編119条(e)項の利益を主張する。

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

(Application No.)
(出願番号)

(Filing Date)
(出願日)

(Application No.)
(出願番号)

(Filing Date)
(出願日)

私は、ここに、下記のいかなる米国出願についても、その米国家典第35編第120条に基づく利益を主張し、又米国を指定するいかなるPCT国際出願についても、その同第365条(c)に基づく利益を主張する。また、本出願の各特許請求の範囲の主題が、米国家典第35編第112条第1段に規定された態様で、先行する米国出願又はPCT国際出願に開示されていない場合においては、その先行出願の出願日と本国内出願日またはPCT国際出願日との間の期間中に入手された情報で、連邦規則法典第37編規則1.56に定義された特許性に関わる重要な情報について開示義務があることを承認する。

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 120 of any United States application(s), or 365(C) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code Section 112. I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of application.

PCT/JP2004/017192

November 18, 2004

PENDING

(Application No.)
(出願番号)

(Filing Date)
(出願日)

(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(現況: 特許許可、係属中、放棄)

(Application No.)
(出願番号)

(Filing Date)
(出願日)

(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(現況: 特許許可、係属中、放棄)

私は、ここに表明された私自身の知識に関わる陳述が真実であり、且つ情報と信ずることに基づく陳述が、真実であると信じられることを宣言し、さらに、故意に虚偽の陳述などを行った場合は、米国家典第18編第1001条に基づき、罰金または拘禁、若しくはその両方により処罰され、またそのような故意による虚偽の陳述は、本出願またはそれに対して発行されるいかなる特許も、その有効性に問題が生ずることを理解した上で陳述が行われたことを、ここに宣言する。

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Japanese Language Declaration

(日本語宣言書)

委任状： 私は本出願を審査する手続を行い、且つ米国特許商標庁との全ての業務を遂行するために、記名された発明者として、下記の弁護士及び／または弁理士を任命する。(氏名及び登録番号を記載すること)

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and trademark Office connected therewith (list name and registration number)

Ronald R. Snider - 24,962; Paul L. Brown # 27,184

書類送付先	Send Correspondence to: Ronald R. Snider PO Box 27613 Washington, DC 20038-7613
直通電話連絡先：(氏名及び電話番号)	Direct Telephone Calls to: (name and telephone number) Ronald R. Snider 202-347-2600

唯一または第一発明者氏名 山田 透	Full Name of sole or first inventor YAMADA, Toru
発明者の署名 山田 透	Inventor's signature <i>Toru Yamada</i>
日付	Date <i>May 18, 2006</i>
住所 379-0196 日本国群馬県安中市磯部二丁目13番1号 信越半導体株式会社 半導体磯部研究所内	Residence c/o SHIN-ETSU HANDOTAI CO., LTD., Isobe R&D Center, 13-1, Isobe 2-chome, Annaka-shi, Gunma 379-0196 JAPAN
国籍 日本国	Citizenship JAPANESE
私書箱 379-0196 日本国群馬県安中市磯部二丁目13番1号 信越半導体株式会社 半導体磯部研究所内	Post Office Address c/o SHIN-ETSU HANDOTAI CO., LTD., Isobe R&D Center, 13-1, Isobe 2-chome, Annaka-shi, Gunma 379-0196 JAPAN
第二共同発明者がいる場合、その氏名 八木 真一郎	Full Name of second inventor YAGI, Shinichiro
第二共同発明者の署名 八木 真一郎	Second inventor's signature <i>Shinichiro Yagi</i>
日付	Date <i>May 18, 2006</i>
住所 379-0125 日本国群馬県安中市野谷字松原507 信越半導体株式会社 横野平工場内	Residence c/o SHIN-ETSU HANDOTAI CO., LTD., Yokonodaira Plant, 507, Aza Matsubara, Nakanoya, Annaka-shi, Gunma 379-0125 JAPAN
国籍 日本国	Citizenship JAPANESE
私書箱 379-0125 日本国群馬県安中市野谷字松原507 信越半導体株式会社 横野平工場内	Post Office Address c/o SHIN-ETSU HANDOTAI CO., LTD., Yokonodaira Plant, 507, Aza Matsubara, Nakanoya, Annaka-shi, Gunma 379-0125 JAPAN

(第三以下の共同発明者についても同様に記載し、署名をすること)

(Supply similar information and signature for third and subsequent joint Inventors.)